PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-189525

(43) Date of publication of application: 21.07.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/304

H01L 21/306

(21)Application number : **09-355787**

(71)Applicant : LG SEMICON CO LTD

(22) Date of filing:

24.12.1997

(72)Inventor: HAN SUK-BIN

(30)Priority

Priority number : 96 9671487

487 Priority date : 24.12.1996

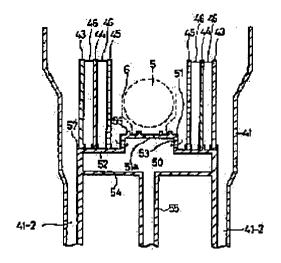
Priority country: KR

(54) DEVICE AND METHOD FOR WAFER WET TREATMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the residual treatment used in the preceding step by a method wherein the tile wet treater is composed of including at least one side member free removably arranged on a bottom face member for the formation of the side of an inner bus.

SOLUTION: An inner bus bottom face 50 is formed in a two stepped shape made of a wafer supporting base 51 positioned in the central part as well as a partition base 52 positioned around the wafer supporting base 51. A hole 51a and a plurality of holes 53 for passing a treatment solution are formed in the wafer supporting base 51. A bottom board 54 so as to form the space for collecting the treatment solution passing through the



holes 53 is provided beneath the wafer supporting base 51 and the partition base 52. A drainage line 55 for draining the treatment solution is connected to almost the central part of this bottom board 54. Besides, the partition covers 46 for preventing the treatment solution from running into partition bards 43, 44, 45 are fitted to the boards 43, 44, 45. In such a constitution, the partition base 52 and the partition boards 43, 44, 45 are structured to secure

the complete contact so that the flow of the treatment solution may be cut off.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.10.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平10-189525

(43)公開日 平成10年(1998) 7月21日

(51) Int.CL⁶ H 0 1 L 21/304 織別紀号 341 ΡI

HOIL 21/304

341T

21/306

21/306

J

審査請求 未請求 請求項の数20 OL (全 11 頁)

(21)出顯番号

特顯平9-355787

(22)出願日

平成9年(1997)12月24日

(31)優先権主張番号

71487/1996

(32)優先日

1996年12月24日

(33)優先権主張国

韓国 (KR)

(71) 出庭人 596034274

エルジー セミコン カンパニー リミテ

ッド

大韓民國、チューンチェオンプクード、チェオンジュ、フンダクーグ、ヒャングジェ

オンードン、1

(72) 発明者 スクーピン ハン

大韓民国、チューンチェオンブクード、チェオンジュ、 フンダクーグ、ポンミュン

-2-ドン(番地なし)

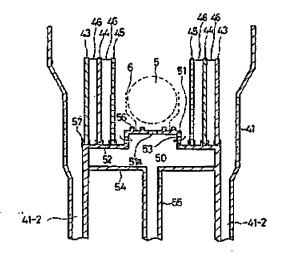
(74)代理人 弁理士 管島 富二雄 (外1名)

(54)【発明の名称】 ウェーハ波式処理装配及び方法

(57)【要約】

【課題】 前工程における幾個処理液によるウェーハの 汚染を防止する。

【解決手段】 ウェーハ5の湿式処理を行う内部バスと、内部バスの周囲に設置される外部バス41と、外部バス41に接続され、外部バス41に処理液を供給或いは外部バス41から処理液を排出する排出ライン41~2と、内部バスに接続され、内部バスに処理液を供給或いは内部バスから処理液を排出する排出ライン55と、を含んで構成されるウェーハ湿式処理装置において、内部バスは、内部バスの底面を形成する内部バス底面50と、内部バスの側面を形成する少なくとも1つの仕切り(図においては仕切り43、44、45)と、を含んで構成した。



特闘平10−189525

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】ウェーハの湿式処理を行う内部バスと、 該内部バスの周囲に設置される外部バスと、 該外部バスに接続され、外部バスに処理液を供給或いは 外部バスから処理液を排出する第1のラインと. 前記内部バスに接続され、内部バスに処理液を供給取い は内部バスから処理液を排出する第2のラインと、 を含んで構成されるウェーハ湿式処理装置において、 前記内部バスは、内部バスの底面を形成する底面部材 と、該底面部村上に取り外し自由に設置され、内部バス 10 の側面を形成する少なくとも1つの側面部材と、を含ん で構成されるととを特徴とするウェーハ湿式処理装置。 【請求項2】前記第2のラインが、前記内部バスから処 理波を排出する排出ラインとしての役割をする時、前記 第1のラインは、前記外部バスに処理液を供給する供給 ラインとしての役割をする構成である請求項1記載のウ ェーハ湿式処理装置。

【請求項3】前記第2のラインが、前記内部バスに処理 液を供給する供給ラインとしての役割をする時、前記第 1のラインは、前記外部バスから処理液を排出する排出 20 該連通ラインに介装されるポンプ及びフィルターと、 ラインとしての役割をする構成である請求項1記載のウ ェーハ湿式処理装置。

【請求項4】前記底面部材の下に、処理液を収集する空 間を形成する中間バスが設けられる構成である請求項1 ~3のいずれか1つに記載のウェーハ湿式処理装置。

【請求項5】前記底面部村は、前記側面部材を支持する 支持台と、前記ウェーハを支持するウェーハ支持台と、 を含んで構成され、

前記ウェーハ支持台は、前記支持台より高位置になるよ うに形成された請求項1~4のいずれか1つに記載のウ 30 該内部バスの周囲に設置される外部バスと、 ェーハ湿式処理装置。

【請求項6】前記側面部村には、隣接する側面部村間へ の処理液の流入を防止するカバーが設けられる構成であ る請求項1~5のいずれか1つに記載のウェーハ湿式処 選装置。

【請求項7】前記側面部特は、夫々異なる高さに形成さ れる構成である請求項1~6のいずれか1つに記載のウ ェーハ湿式処理装置。

【請求項8】前記側面部特は、最内部から最外部に向か ってその高さが高くなるように形成される構成である請 40 求項?記載のウェーハ湿式処理装置。

【請求項9】前記側面部村は、最内部から最外部に向か ってその高さが低くなるように形成される構成である請 求項?記載のウェーハ湿式処理装置。

【請求項10】前記側面部村と底面部村との間には、処 理液の漏洩を防止する漏洩防止部材が設けられる構成で ある請求項1~9のいずれか1つに記載のウェーハ湿式 処理装置。

【請求項11】洗浄液を噴射する噴射器と、

前記内部バス及び外部バスとは別体に設けられ、該頓射 50 構成である請求項1.5 記載のウェーハ湿式処理方法。

器から噴射される洗浄液により前記側面部材の洗浄を行 ろ洗浄バスと.

を含んで模成される請求項1~10のいずれか1つに記 戴のウェーハ湿式処理装置。

【請求項】2】前記側面部付は、分離可能に構成される

洗浄液を噴射する第1及び第2の噴射器と、

前記内部バス及び外部バスとは別体に設けられ、該第1 或いは第2の噴射器から噴射される洗浄液により、分離 された側面部村の洗浄を行う第1及び第2の洗浄バス

を含んで構成される請求項1~10のいずれか1つに記 戴のウェーハ温式処理装置。

【請求項13】前記第1及び第2のラインには、処理液 を供給する処理液供給器が接続される構成である請求項 1~12のいずれか1つに記載のウェーハ湿式処理装 遌.

【請求項14】前記第1のラインと第2のラインとを連 通する連通ラインと、

を含んで再循環機が構成され、

前記再循環機は、前記内部バス或いは外部バスから排出 された処理液を前記フィルターにより濾過し、濾過され た処理液を前記ポンプにより内部バス或いは外部バスに 再循環させる構成である請求項1~13のいずれか1つ に記載のウェーハ湿式処理装置。

【請求項15】底面を形成する底面部村及び側面を形成 する少なくとも1つの側面部材から構成され、ウェーハ の湿式処理を行う内部バスと、

該外部バスに接続され、外部バスに処理液を供給或いは 外部バスから処理液を排出する第1のラインと、

前記内部バスに接続され、内部バスに処理液を供給或い は内部バスから処理液を排出する第2のラインと、 を含んで構成され、

前記第1のライン及び外部バスを介して内部バスに第1 の処理液を供給する工程と、

前記第2のラインを介して内部バスから第1の処理液を 排出する工程と

前記内部バスを構成する側面部材のうち、前記第1の処 理液と接触した側面部材を除去する工程と、

前記第1のライン及び外部バスを介して内部バスに第2 の処理液を供給する工程と、

前記第2のラインを介して内部バスから第2の処理液を 排出する工程と.

を含んで構成されることを特徴とするウェーハ湿式処理

【請求項16】前記側面部村を除去する工程は、洗浄用 バスに側面部村を移して側面部村を洗浄する工程を含む

(3)

【請求項17】底面を形成する底面部村及び側面を形成 する少なくとも1つの側面部材から構成され、ウェーハ の過式処理を行う内部バスと、

3

該内部バスの周囲に設置される外部バスと、

該外部バスに接続され、外部バスに処理液を供給或いは 外部バスから処理液を排出する第1のラインと.

前記内部バスに接続され、内部バスに処理液を供給或い は内部バスから処理液を排出する第2のラインと、 を含んで構成され、

前記第2のラインを介して内部バスに第1の処理液を供 10 給する工程と.

該内部バスに供給された第1の処理液を外部バスに流す 工程と...

前記第1のラインを介して外部バスから第1の処理液を 排出する工程と、

前記内部バスを構成する側面部材のうち、前記第1の処 運搬と接触した側面部材を除去する工程と、

前記第2のラインを介して内部バスに第2の処理液を供給する工程と

を含んで構成されることを特徴とするウェーハ湿式処理 20 方法。

【請求項18】前記側面部村を除去する工程は、洗浄用 バスに側面部村を移して側面部村を洗浄する工程を含む 構成である請求項17記載のウェーハ湿式処理方法。

【請求項19】前記第2の処理液は、前記第1の処理液が流れる方向と反対方向に、第1のラインを介して内部バスに供給される構成である請求項17記載のウェーバ湿式処理方法。

【請求項20】前記第2の処理液は、前記第2ラインを 介して排出される構成である請求項19記載のウェーハ 30 湿式処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造工程で使用されるウェーハ湿式処理装置及び方法に関し、特に、残留処理液による汚染を防止する技術に関する。 【0002】

【従来の技術】半導体製造工程において、湿式にウェーハ(薄い原板)を処理する工程には、触刻工程と洗浄工程とがある。触刻工程で使用されるウェーハ湿式処理装置は、主に、処理情(BATH)に処理液(CHEMICAL SOLUTION:化学菜品)を満たしてからウェーハを入れ、所定時間の間化学反応が起こるようにする方法を使用するものである。一方、処理工程で使用されるウェーハ湿式処理装置は、主に、処理槽の底から処理液が供給され、処理槽から溢れ出る処理液が外部タンクに排出されるか、或いは、処理槽に再循環させるようにする方式を使用するものである。ウェーハ湿式処理装置は、処理槽に処理液を供給或いば排出するバイブと、処理液の温度または流気を制御するための各種制御手段と、を含くて環境な

れる。そして、ウェーハ湿式処理装置は、処理槽での処理液の流れ方向を基準として、オーバーフロー型とダウンフロー型とに分けられるが、その概略を示すと図12のようになる。

【① ① ② 3 】即ち、ウェーハ湿式処理装置は、内部バス(処理権)11と外部バス(排出または注入用筒)12とを有しており。内部バス11及び外部バス12は、上部が開口し、下部には供給ライン14又は排出ライン15が夫々接続されている。そして、供給ライン14及び排出ライン15に、処理液が図12の矢印方向に流れるとオーバーフロー型となり。その反対方向に処理液が流れるとダウンフロー型となる。

【0004】オーバーフロー型では、内部バス11には、処理対象のウェーハ5がウェーハカセットまたはキャリア6に保持されつつ内部バス11の中に安置される。そして、供給ライン14を介して内部バス11に供給された処理液は、ウェーハ5を処理した後、内部バス11をオーバーフローして外部バス12に溢れ出ると、外部バス15の下部に接続された卵出ライン15を介して排出される。この卵出された処理液は、ボンブにより内部バス11に再循環されるか、或いは、図示しない貯蔵タンクに卵出される。ダウンフロー型は、以上の説明と反対の方向に処理液が流れる。

【0005】図13は、多数の処理槽を有するウェーハ 湿式処理装置を図示したものである。このウェーハ湿式 処理装置は、処理槽が一列に4個連結されてなるもので ある。このウェーハ湿式処理装置を利用した処理方式 は、例えば、ウェーハ5を第1処理槽21に入れてある 化学処理をした後、ウェーハ5を算2処理槽22に移し て他の化学処理し、というように次々とウェーハ5を第 3処理槽23、第4処理槽24に移して化学処理をす

【0006】図14は、ダウンフロー型のウェーハ湿式 処理装置を戦略的に図示した図面である。内部バス31 には、処理対象のウェーハ5が、ウェーハカセットまた はキャリア6に保持されつつ安置される。そして、供給 ラインヘッド34を介して外部バス32に供給された処理液は、内部バス31の上部の縁をオーバーフローして 内部バス31内に流れ込んで、ウェーハ5に対して化学 処理をしてから、内部バス31の下部に接続された鉄出 ライン35を介して鉄出される。この時に鉄出された処理液は、図示しない鉄出される。2に再循環されるか、或いは、図示しない鉄出用処理液の貯蔵タンクに鉄出される。

 (4)

水供給ライン39もレギュレーター40を介して接続さ れている。供給ラインヘッド34に接続される各処理液 供給ライン36及び総水供給ライン40には、処理液又

5

は純水の流量を副御する副御バルブ等が介装される。 【0008】次に、このように構成されたダウンプロー 型のウェーハ湿式処理装置を利用し、ウェーハ5を湿式 処理する工程について説明する。まず、供給ラインヘッ ド34、外部バス32及び内部バス31を純水(DI-Wate 市で洗浄してから、ウェーハ5を内部バス31に安置。 し、必要な処理液を選択して外部バス32及び内部バス 10 31に処理液を供給して湿式処理をする。このような処 **塑は、制御バルブを手動で操作したり、或いは、副御バ** ルブを自動的に操作すればよい。

【0009】最近は、半導体デバイスの高集績化によっ て、ウェーハを処理する処理技術と、ウェーハを処理す る処理装置の重要性が増大されつつある。ウェーハ処理 装置によるウェーハ5の汚染も、デバイスの信頼性に大 きい影響を及ぼすので、ウェーハの処理効果の低下は勿 論。チップの致命的な不良を誘発する場合もあるからで ことにより、従来の技術では、処理装置の処理液タンク も大きくなるので、処理装置の全体的な大きさを減らす ために、装置の部品及び処理槽の最適化を達成するため の努力がなされている。

【①①10】従来の技術における多段階湿式処理工程で は、前工程で使用された処理液中の化学薬品(CHEMICA L)、及び、運搬時に流入されたパーティクル(PARTICL E)等が、ウェーハキャリア(BOAT)の潜の隙間に流入され 素積され、結局、汚染源(CONTAMINATION SOURCE)として **運渡でウェーハ5を処理してから、次の処理槽にウェー** ハ5を移して他の処理液で処理を行い、また、次の工程 で他の処理液でウェーハ6を処理し、必要な工程を経て から、最終段階では絶水洗浄槽を利用し最後の処理工程 を行う。

$\{0011\}$

【発明が解決しようとする課題】前記の工程等は、各工 程毎に別途の処理措が必要となり、純水バスシステムも それぞれの処理槽による差別化が行われるべきである。 このような多段階湿式処理工程で使用されるシステムの 短所として指摘されることは、装置全体の容積が大きく なるという点と、特に、ウェーハが大口径化されつつあ ることによって、処理槽の大きさも大きくなり、処理槽 全体の容置の増加によって、装置が占める全体の容積が 増加するという点である。

【0012】とのような問題を解決するために最近で は、ワンパスシステムが採用されている。このワンパス システムは、各工程で1個の処理槽を使用するが、各工 程で使用する処理液は、各工程に必要なものを入れ替え 処理槽で多様な工程を行うことによって、多数の処理槽 を有するシステムで必要とした、処理槽の数を減らすこ とができるという利点がある。

【0013】しかし、バスシステムの全体の大きさを減 ちずために、ワンバスシステムが開発されたが、各工程 で使用される異なる処理液を同一処理槽で使用するの で、次のような問題が惹起される。例えば、前工程で使 用された処理液を完全に除去し、処理槽の中を維水等で きれいに洗浄処理してから、次の工程で使用される処理 液を処理槽の中に注入して次の工程を行うので、各処理 工程を行う前の掌備時間が長くなると共に、消費される 処理液や純水量が非常に多くなる。また、処理槽の側壁 の残存処理液等が完全に除去されない場合もあって、次 の工程における信頼性が低下する。

【0014】ワンバスシステムを絶水洗浄工程専用とし て使用する場合でも、前工程での残存処理液を確実に除 去するために、多量の処理液を消費するという問題はま だ残る。そこで、本発明はかかる従来技術の問題点に鑑 み、内部バスの構造を見直すことで、前工程における残 湿式処理装置及び方法を提供することを目的とする。

100151

【課題を解決するための手段】このため、請求項1記載 の発明は、ウェーハの湿式処理を行う内部バスと、該内 部バスの周囲に設置される外部バスと、該外部バスに接 続され、外部バスに処理液を供給或いは外部バスから処 理液を排出する第1のラインと、前記内部バスに接続さ れ、内部バスに処理液を供給或いは内部バスから処理液 を排出する第2のラインと、を含んで構成されるウェー 作用するようになる。すなわち、最初の工程で、或る処 30 ハ湿式処理装置において、前記内部バスを、内部バスの 底面を形成する底面部材と、該底面部材上に取り外し自 由に設置され、内部バスの側面を形成する少なくとも1 つの側面部材と、を含んで構成した。

> 【0016】かかる構成によれば、ウェーハの湿式処理 を行う際には、先ず、1つの側面部材を設置して内部バ スを形成してから、第1或いは第2のラインを介して処 **理液を内部バスに供給する。その後、内部バスにおいて** ウェーハの湿式処理を行い、第1取いは第2のラインを 介して処理液を外部に排出する。次に、処理液と接触し 40 た側面部材を取り除き、内部バスの底面を形成する底面 部材を洗浄する。そして、他の側面部材を設置して内部 バスを形成してから、第1或いは第2のラインを介して 他の処理液を内部バスに供給する。その後、内部バスに おいてウェーハの湿式処理を行い、第1或いは第2のラ インを介して他の処理液を外部に排出する。このよう に、各工程において、異なる側面部村により内部バスを 形成するようにすれば、前工程における残存処理液が極 力減少する。

【0017】請求項2記載の発明は、前記第2のライン て使用する方式である。このワンパスシステムは、同一 50 が、前記内部パスから処理液を排出する排出ラインとし

ての役割をする時、前記第1のラインは、前記外部バス に処理液を供給する供給ラインとしての役割をする構成 とした。かかる構成によれば、第1のラインを介して外 部バスに供給された処理液は、内部バスの上部を越えて 内部バスに供給される。そして、内部バスに供給された 処理液は、第2のラインを介して外部に排出される。従 って、ダウンプロー型のウェーハ湿式処理装置が容易に 寒現される。

7

【0018】請求項3記載の発明は、前記第2のライン が、前記内部バスに処理液を供給する供給ラインとして 10 の役割をする時、前記第1のラインは、前記外部バスか ら処理液を排出する排出ラインとしての役割をする構成 とした。かかる構成によれば、第2のラインを介して内 部バスに供給された処理液は、内部バスの上部を越えて 外部バスに溢れ出る。そして、外部バスに溢れ出た処理 液は、第1のラインを介して外部に排出される。従っ て、オーバープロー型のウェーハ湿式処理装置が容易に 実現される。

【0019】請求項4記載の発明は、前記底面部材の下 れる構成とした。かかる構成によれば、内部バスの底部 に残存する処理液は、中間バスに収集されるので、内部 バスに残存する処理液の量が少なくなる。請求項5記載 の発明は、前記底面部材を、前記側面部材を支持する支 特台と、前記ウェーハを支持するウェーハ支持台と、を 含んで構成し、前記ウェーハ支持台を、前記支持台より 高位置になるように形成した。

【0020】かかる構成によれば、内部バスの底部に残 存する処理液は、より低位置に形成された支持台に流れ なる。請求項6記載の発明は、前記側面部材には、隣接 する側面部材間への処理液の流入を防止するカバーが設 けられる模成とした。

【①①21】かかる構成によれば、隣接する側面部材間 に処理液が流入しなくなるので、ウェーハの湿式処理を 行う際に、予め複数の側面部材を設置することができ る。そして、各工程の修了後、処理液と接触した側面部 材及びカバーを除去するようにすれば、残留処理液によ るウェーハの汚染を防止しつつ、各工程の準備時間が短 縮する。

【①①22】請求項7記載の発明は、前記側面部村を、 夫々異なる高さに形成した。請求項8記載の発明は、前 記側面部材を、最内部から最外部に向かってその高さが 高くなるように形成した。請求項9記載の発明は、前記 側面部材を、最内部から最外部に向かってその高さが低 くなるように形成した。

【0023】請求項10記載の発明は、前記側面部材と 底面部材との間には、処理液の漏洩を防止する漏洩防止 部材が設けられる構成とした。かかる構成によれば、側

で、ウェーハ湿式処理装置の信頼性が向上する。請求項 11記載の発明は、洗浄液を噴射する噴射器と、前記内 部バス及び外部バスとは別体に設けられ、該贖射器から 順射される洗浄液により前記側面部材の洗浄を行う洗浄 バスと、を含む構成とした。

【0024】かかる構成によれば、ウェーハの湿式処理 を行いつつ、前工程で使用した側面部材の洗浄が行われ るので、処理効率が向上する。請求項12記載の発明 は、前記側面部村を、分離可能に構成すると共に、洗浄 液を噴射する第1及び第2の噴射器と、前記内部バス及 び外部バスとは別体に設けられ、該第1或いは第2の贖 射器から噴射される洗浄液により、分離された側面部材 の洗浄を行う第1及び第2の洗浄バスと、を含む構成と した。

【0025】かかる樺成によれば、ウェーハの湿式処理 を行いつつ、前工程で使用した側面部材を分離して洗浄 が行われるので、処理速度及び洗浄度が向上する。ま た。側面部材が分離可能に構成されることで、洗浄バス が小型化する。請求項13記載の発明は、前記第1及び に、処理液を収集する空間を形成する中間バスが設けら、20、第2のラインには、処理液を供給する処理液供給器が接 続される模成とした。

【10026】かかる構成によれば、第1或いは第2のラ インを介して内部バスに処理液が供給されるので、処理 液の供給方向を切り換えることで、ウェーハ湿式処理装 置をダウンフロー型或いはオーバーフロー型に切り換え るととができる。請求項14記載の発明は、前記第1の ラインと第2のラインとを連通する連通ラインと、該連 通ラインに介装されるポンプ及びフィルターと、を含ん で再循環機を構成し、前記再循環機は、前記内部バス取 出るので、内部バスに残存する処理液の置がより少なく 30 いは外部バスから排出された処理液を前記フィルターに より濾過し、濾過された処理液を前記ポンプにより内部 バス或いは外部バスに再循環させる構成とした。

【①①27】かかる榛成によれば、第1或いは第2のラ インから排出される処理液は、フィルターにより濾過さ れつつ内部バスに再循環されるので、処理液中に含まれ る異物等が除去され、ウェーハの汚染が防止される。請 求項15記載の発明は、底面を形成する底面部材及び側 面を形成する少なくとも1つの側面部材から構成され、 ウェーハの湿式処理を行う内部バスと、該内部バスの周 46 聞に設置される外部バスと、該外部バスに接続され、外 部バスに処理液を供給取いは外部バスから処理液を排出 する第1のラインと、前記内部バスに接続され、内部バ スに処理液を供給或いは内部バスから処理液を排出する 第2のラインと、を含んで構成され、前記第1のライン 及び外部バスを介して内部バスに第1の処理液を供給す る工程と、前記第2のラインを介して内部バスから第1 の処理液を排出する工程と、前記内部バスを構成する側 面部村のうち、前記第1の処理液と接触した側面部材を 除去する工程と、前記第1のライン及び外部バスを介し 面部村と底面部村との間から処理液が漏洩しなくなるの 50 て内部バスに第2の処理液を供給する工程と、前記第2

(6)

のラインを介して内部バスから第2の処理液を排出する 工程と、を含んでウェーハ湿式処理方法を構成した。 【0028】かかる構成によれば、ウェーハを湿式処理 する際には、先ず、第1のライン及び外部バスを介して 内部バスに第1の処理液を供給する。そして、第2のラ インを介して内部バスから第1の処理液を排出した後、 第1の処理液と接触した側面部材を除去する。その後、 同様にして、第1のライン及び外部バスを介して内部バ

スに第2の処理液を供給し、第2のラインを介して内部 バスから第2の処理液を排出する。従って、内部バスを 10 構成する側面部付は、各工程毎に異なるものが使用され るので、内部バスに残存する処理液が減少する。

【0029】請求項16記載の発明は、前記側面部材を 除去する工程は、洗浄用バスに側面部村を移して側面部 材を洗浄する工程を含む構成とした。かかる構成によれ は、ウェーハの温式処理と側面部材の洗浄とが同時に行 われるので、処理効率が向上する。請求項17記載の発 明は、底面を形成する底面部材及び側面を形成する少な くとも1つの側面部材から構成され、ウェーハの湿式処 選を行う内部バスと、該内部バスの周囲に設置される外 20 部バスと、該外部バスに接続され、外部バスに処理液を 供給或いは外部バスから処理液を排出する第1のライン と、前記内部バスに接続され、内部バスに処理液を供給 或いは内部バスから処理液を排出する第2のラインと、 を含んで構成され、前記第2のラインを介して内部バス に第1の処理液を供給する工程と、該内部バスに供給さ れた第1の処理液を外部バスに流す工程と、前記第1の ラインを介して外部バスから第1の処理液を排出する工 程と、前記内部バスを構成する側面部村のうち、前記第 第2のラインを介して内部バスに第2の処理液を供給す る工程と、を含んでウェーハ湿式処理方法を構成した。 【0030】かかる構成によれば、ウェーハを湿式処理 する際には、先ず、第2のラインを介して内部バスに第 1の処理液を供給する。そして、第1のラインを介して 内部バスから第1の処理液を排出した後、第1の処理液 と接触した側面部材を除去する。その後、同様にして、 第2のライン介して内部バスに第2の処理液を供給す る。従って、内部バスを構成する側面部材は、各工程毎 に異なるものが使用されるので、内部バスに残存する処 40 理液が減少する。

【0031】請求項18記載の発明は、前記側面部材を 除去する工程は、洗浄用バスに側面部材を移して側面部 材を洗浄する工程を含む構成とした。かかる模成によれ は、ウェーハの湿式処理と側面部材の洗浄とが同時に行 われるので、処理効率が向上する。請求項19記載の発 明は、前記第2の処理液は、前記第1の処理液が流れる 方向と反対方向に、第1のラインを介して内部バスに供 給される機成とした。

液は、前記第2ラインを介して排出される構成とした。 [0033]

【発明の実施の形態】図1は、本発明に係るウェーハ湿 式処理装置の第1実施例を示す斜視図であり、図2は、 図1中のV-V線断面図である。ウェーハ湿式処理装置 は、外部バス41と、この外部バス41内に設置される 内部バス底面50と、内部バス底面50(底面部材)上 に設置され、内部バスを形成する仕切り43、44、4 5 (側面部材)と、を含んで構成される。

【0034】外部バス41の底面には、内部バスと外部 バス41との間に供給されるか、或いは、内部バスと外 部パス41との間から排出される処理液の排出ライン4 1-2(第1のライン)が形成されている。内部バス底 面50は、中央部に位置するウェーハ支持台51と、ウ ェーハ支持台51の周囲に位置する仕切り支え台52 (支持台)と、からなる2段の段付き形状に形成され る。ウェーハ支持台51は、仕切り支え台53より高位 置になるように形成され、その略中央部及び周囲の側壁 には、処理液が通過する孔51 a及び複数の孔53が失 ャ形成されている。なお、ウェーハ支持台51の孔53 は、省略してもよい。ウェーハラを支持するウェーハキ ャリア6は、図2の点線で示すように、このウェーハ支 締台51の上に設置される。ウェーハ支持台51の上面 には、ウェーハキャリア6が確実に固定されるように、 適当な凹凸部56を形成することが好ましい。また、ウ ェーハ支持台51及び仕切り支え台52の下部には、中 間バス、即ち、ウェーハ支持台51に形成された孔53 を通過した処理液を収集するための空間を形成する下板 54が設置される。そして、この下板54の略中央部に 1の処理液と接触した側面部材を除去する工程と、前記 30 は、処理液を排出するための排出ライン55 (第2のラ イン) が接続されている。

【0035】さらに、仕切り板43、44,45の間に は、仕切り板間に処理液が流入されないようにする仕切 りカバー46(カバー)が取り付けられる。この他に は、仕切り支え台52と仕切り43、44、45とは、 処理液の流通が遮断され得るように完全に密着される機 造からなる。この密者構造は、仕切り支え台52に凹凸 部57を形成し、仕切り43,44、45の下部には、 パッキン等(漏洩防止部村)を付着し、仕切り43,4 4、45自体の重置により処理液が仕切り43、44, 4.5 と仕切り支え台5.2 との間を通過できないようにす るとよい。

【0036】図3は、オーバフロー型のウェーハ湿式処 **塑装置における処理液供給システムを示している。すな** わち、排出ライン55から処理液が供給され、排出ライ ン41-2から処理液が排出される。ウェーハ湿式処理 装置には、各種処理液が蓄積されるケミカルタンク37 (処理液供給器)から、処理液供給ライン36.ポンプ 27 b、バルブ26 b 及び主処理液供給ライン33を介 【① 032】請求項20記載の発明は、前記第2の処理 50 して処理液が供給される。主処理液供給ライン33に

は、各ケミカルタンク37と接続される処理液供給ライ ン36が複数接続されており、各処理液供給ラインに介 装されるバルブにより、ウェーハ湿式処理装置に供給さ れる処理液が切り換わる。また、主処理液供給ライン3 3には、レギュレータ4.0が介装された蒸留水供給ライ ン39が接続され、蒸留水供給ライン39に介装された バルブを開けることで、ウェーハ湿式処理装置に蒸留水 が供給される。

11

【0037】また、ウェーハ湿式処理装置の排出ライン 41-2は、排出タンク25と接続されており、排出ラ 10 イン41-2に介装されるバルブ26aにより、排出タ ング25に排出される処理液の量が調整される。従っ て、バルブ26aを開けたときに、処理液が排出タンク 25に流れ出す。しかし、処理液を主処理液供給ライン 33に再循環させる再循環モードのために、ポンプ27 a及び処理液を濾過する濾過器(filter)28が介装さ れた再循環ライン29 (連通ライン) によって、排出ラ イン41-2と主処理液供給ライン33とが連通されて いる。従って、再循環モードのときには、バルブ26a 及び26hを閉じると、排出ライン41-2から排出さ れる処理液は、ポンプ27aによって加圧され、濾過器 28を通り抜けることで異物が濾過され、主処理液供給 ライン33に再循環される。なお、再循環ライン29、 ボンプ27a及び濾過器28を含んで再循環機が構成さ

【0038】図4は、ダウンフロー型のウェーハ温式処 **運装置における処理液供給システムを示している。即** ち、排出ライン41-2から処理液が供給され、排出ラ イン55から処理液が排出される。なお、図3に示す処 理液供給システムと同一構成には、同一符号を付し、そ 30 の説明は省略する。図5は、オーバーフロー型とダウン フロー型のウェーハ湿式処理装置が結合された処理液供 給システムを示す。即ち、オーバープローモードからダ ウンプローモードに、またはその反対にモードを変える ことができる。従って、この処理液供給システムは、ダ ウンフロー型とオーバーフロー型とを切換可能であるた めに、ただ1つのウェーハ湿式処理装置を含んで構成さ れ、流入される汚染物質を減らす方法が盛り込まれてお り、いくつかの長所を有している有用な装置である。こ のダウンフロー/オーバーフロー装置に関する詳細な説 明は、1996年2月23日付の米国特許出願番号08 /606,188で説明されている。

【0039】次に、かかる構成からなるダウンフロー型 のウェーハ湿式処理装置の作用について説明する。先 ず、洗浄液としての蒸留水を鲱出ライン41-2から供 給して、ウェーハ湿式処理装置の内部を洗浄する。そし て、外部バス41内部の仕切り支え台52の上に最も外 側に位置する仕切り43を設置し、ウェーハ5をウェー ハキャリア6に安置してから、処理液を排出ライン41 - 2から供給してウェーハらに対して必要な化学処理を 50 クやロボット等は、従来で使用したものと同一である

行ってから、排出ライン55から使用した処理液を排出 させる。その後、図示しない順射器を利用し秩浄液を順 射させて、ウェーハ5と外部バス41内部とを洗浄す

【0040】次は、仕切り44を仕切り43の内側に設 置し、上記と同様な手順を繰返して、ウェーハらに対し て必要な処理を施してから更に洗浄する。このような工 程を、最も内側に位置する仕切り45を使用するまで反 後する。なお、図1及び図2においては、3つの仕切り 43、44、45が設置されているが、実際には最も外 側に位置する仕切り43と最も内側に位置する仕切り4 5のと間に、中間サイズの仕切りを多数使用することが でき、その数は必要な工程の数によって選択され得る。 【①①41】前記のように使用する方法が便利ではある が、仕切り43、44、45の中のいずれか1つを使用 して処理槽たる内部バスを形成し、湿式処理工程を完了 してから、噴射器を利用して洗浄し、使用した仕切りを 除去した後、別の仕切りを設置し、更にその次に湿式工 程を行ってもよい。また、仕切りを、最初に必要とする 20 数だけ設置してから、1工程が完了してから1つづつ除 去しつつ、湿式工程を行うようにしてもよい。

【0042】以上の説明のとおり、本発明に係るウェー ハ湿式処理装置を使用すると、従来技術の問題点を解消 することができる。すなわち、ウェーハ支持台5 1 を内 部バス底面50より高い位置に形成することによって、 ダウンフローの流れによって、処理液出口及びウェーハ キャリア6の支持部に付着した汚染物等が、ウェーハ5 を汚染させることを最大限に防止することができる。ま た。処理槽を内部バス底面50上に仕切り43、44, 4.5を設置することで形成し、工程別にこの仕切りを変 更するように設置することで、前工程での残留処理液に よるウェーハ5の汚染の問題を解決することができる。 【0043】図6及び図7は、本発明に係るウェーハ湿 式処理装置の第2実施例を示す斜視図である。即ち、第 2 実施例では、第1 実施例におけるウェーハ湿式処理装 置61の瞬りに、内部バスを形成する仕切り43、4 4、45を洗浄するための洗浄用バス60(洗浄バス) を付設したものである。また、洗浄用バス60には、仕 切り43、44、45を洗浄するために、洗浄液を順射 する移動式の噴射器が設置される。噴射器は、図示しな い洗浄液タンク等から洗浄液が供給される洗浄液ライン 62と、洗浄波ライン62に接続され、複数の技部63 aを有する順射器ヘッド63と、各技部63aに複数取 り付けられ、洗浄液を噴射するノズル64と、を含んで 模成される。そして、洗浄液ライン62を介して供給さ れた洗浄液は、噴射器ヘッド63の各枝部63aに分岐 され、ノズル64から噴射される。

【①①44】なお、かかる場合、ウェーハ湿式処理装置 で仕切り43、44、45や順射器を移動させるチャッ

が、この場合に必要な治具や付着手段が追加される。次 に、かかる構成からなるウェーハ湿式処理装置の作用に ついて説明する。ウェーハ湿式処理装置は、先の第1案 施例で説明したように使用することもできるが、ウェー ハ5を処理液で湿式処理してから、仕切り43、44, 4.5 を洗浄用バス6.0 に移し、洗浄工程と化学処理工程 とを同時に実施することもできる。すなわち、1つの内 部バス用の仕切りを設置して或る処理工程を行なってか 5. 該当工程で使用した仕切りを除去し、別の仕切りを 設置して次の工程を行いつつ、使用済みの仕切りを洗浄 10 程で使用される仕切り43a,44a、45aを汚染さ することができるので、迅速にウェーハ5の湿式処理工 程を行うことができる。要するに、温式処理工程を行い つつ。洗浄工程を同時に行うことができ、ウェーハ5を 移動せずに、異なる工程を行うことができるので、工程 進行効率を極力向上するととができる。

13

【0045】なお、図7は、図6における頓射器を上に 移動させた後の状態を示した斜視図である。図8は、本 発明に係るウェーハ湿式処理装置の第3実施例を示す斜 視図である。即ち、第3実施例では、第1実施例におけ する仕切り43、44、45を洗浄するための洗浄用バ ス80,81 (第1、第2の洗浄バス)を付設したもの である。各洗浄用バス80、81には、仕切りを洗浄す るための噴射器 (第1、第2の噴射機) が夫々設置され る。また、内部バスを形成する仕切り43,44、45 は、分離可能な4つの板83から形成される。そして、 仕切り43,44,45を洗浄する際には、仕切り4 3、44、45を4つの板83に分離し、このように分 離された板83を洗浄用バス80、81に入れて洗浄す る。この洗浄用バス80、81には、その四方側面に洗 30 る。 巻波を噴射するノズル84(洗巻液供給ラインの図示は 省略する〉が設置され、上部には順射器85が設置され る。このように構成すると、洗浄用バス80、81をさ らに小型化することができる。

【0046】従って、第3実施例では、仕切り43、4 4、45を4つの板83に分離してから洗浄するので、 洗浄速度と洗浄度を更に向上することができる。図9 は、本発明に係るウェーハ湿式処理装置の第4実施例を 示す断面図である。即ち、第4 実施例では、第1 実施例 り除き、ウェーハキャリア6及び仕切り43、44、4 5を下板54に直接設置するようにしたものである。 【0047】従って、先の第1実施例より簡単な構造な がら、処理液は内部バスの底部に接続された排出ライン 55から鎌出(ダウンフロー型の場合)、或いは、供給 (オーバーフロー型の場合)される。第4 実施例でもま た、処理液の中に汚染物質が入って、後続する工程で使 用される仕切り43、44、45を汚染させないよう に、仕切り43、44,45間の空間を覆うために、仕 切りカバー46を含むことができる。

【0048】図10と図11は、本発明に係るウェーハ 湿式処理装置の第5及び第6実施例を示す断面図であ る。即ち、第5及び第6実施例は、仕切り43、44, 45の高さが異なるという点を除いては、第4実施例と 略同一権成である。具体的には、図10の第5実施例で は、内部仕切り45aが外部仕切り43a, 44aより 低く、図11の第6実施例では、内部仕切り45 bが外 部仕切り43b、44bより高い。第5及び第6実施例 でもまた、処理液の中に汚染物質が入って、後続する工 せないように、住切り43a,44a,45a間の空間 を覆うために、仕切りカバー46を含むことができる。 なお、図2に示すように、孔51 a及び53が形成され たウェーハ支持台51を含む内部バスの底部50の下部

14

【10049】第5及び第6実施例で、符号57の部分を 受け入れる区画は、仕切り43a,44a,45aを支 え、処理液が漏洩されることを防止するために使用され 得る。本実施例では、略直角に設置される仕切り43 るウェーハ湿式処理装置61の瞬りに、内部バスを形成 20 a、44a,45aを使用して説明したが、他の形態も 考えられる。例えば、円筒型の仕切りが使用されるか、 または他の多角型の仕切り等が使用され得る。

に板板5.4を設けるようにしてもよい。

【0050】従って、以上説明した第1~第6実施例で は、内部バスのための1個の仕切りを設置して、一工程 を終了してからその仕切りを除去する。そして、次の工 程のために内部バス用の他の仕切りを設置した後、新し い工程が行われる。この時、それ以前に使用された化学 処理波のすべてが排出され、次の工程前に内部バスが蒸 圏水で洗浄される。それから新しい仕切りが設置され

【①①51】なお、関連技術を有する者は、本発明の趣 旨と範囲から外れず、本発明のウェーハ湿式処理装置を 多様に変更及び変化させ得る。従って、請求項及び記載 範囲から想起し得る均等なものを、カバーするようにな っている。

[0052]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1、請求項 15又は請求項17に記載の発明によれば、前工程で使 用された残存処理液が減少するので、ウェーハの汚染を における内部バス底面50及びウェーハ支持台51を取 40 極力少なくすることができる。請求項2記載の発明によ れば、ダウンプロー型のウェーハ湿式処理装置を容易に 実現することができる。

> 【0053】請求項3記載の発明によれば、オーバーフ ロー型のウェーハ湿式処理装置を容易に実現することが できる。請求項4又は請求項5に記載の発明によれば、 内部バスに残存する処理液の畳を効率的に少なくするこ とができる。請求項6記載の発明によれば、残留処理液 によるウェーハの汚染を防止しつつ。各工程の準備時間 を短縮することができる。

50 【0054】請求項10記載の発明によれば、ウェーハ

(9)

特開平10-189525

16

湿式処理装置の信頼性を向上することができる。請求項11.請求項16又は請求項18に記載の発明によれば、処理効率を向上することができる。請求項12記載の発明によれば、処理速度及び洗浄度を向上することができる。また、洗浄バスの小型化を図ることもできる。【0055】請求項13記載の発明によれば、ウェーハ湿式処理装置をダウンフロー型或いはオバーフロー型に任意に切り換えることができる。請求項14記載の発明によれば、処理液中に含まれる異物等が除去され、ウェーハの汚染を防止することができる。

15

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1実施例を示す斜視図

【図2】 図1のV-V断面図

【図3】 同上にオーバープロー型の処理液供給システムを適用した図

【図4】 同上にダウンプロー型の処理液供給システム を適用した図

【図5】 同上にオパープロー型及びダウンフロー型の 切換可能な処理液供給システムを適用した図

【図6】 本発明の第2実施例を示す斜視図

【図7】 同上において噴射器を上げた状態を示す斜視

図

【図8】 本発明の第3実施例を示す斜視図

【図9】 本発明の第4 実施例を示す断面図

【図10】 本発明の第5実施例を示す断面図

*【図】1】 本発明の第6実施例を示す断面図

【図12】 従来のウェーハ湿式処理装置の一例を示す

医面泡

【図13】 従来のウェーハ湿式処理装置の他の一例を

赤す図

【図 14 】 同上における処理液供給システムを説明する図

【符号の説明】

5:ウェーハ

10 27a:ポンプ

28 徳過器

29:再循環ライン

37:ケミカルタンク

41 外部バス

4.1-2:排出ライン

- 43 . 44、45:仕切り

46:仕切りカバー

50:内部バス底面

51:ウェーハ支持台

20 52:仕切り支え台

54:下板

55: 排出ライン

60:洗浄用バス

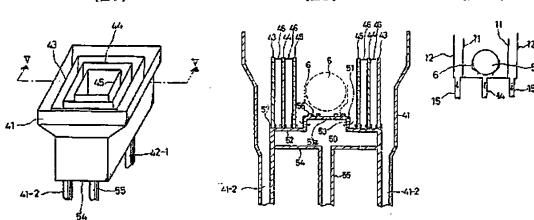
80、81:洗浄用バス

* 85:噴射器

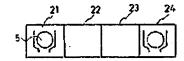
[図1]

[図2]

【図12】

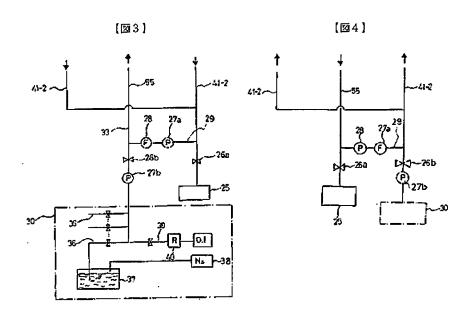


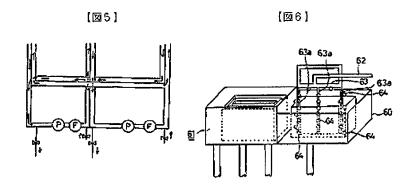
[図13]

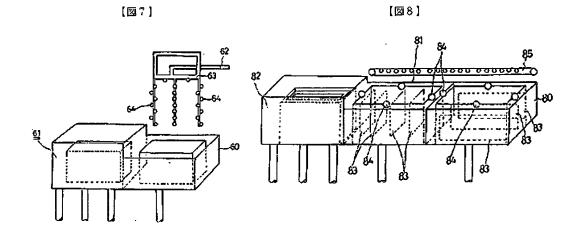


(10)

特闘平10-189525







(11) 特闘平10-189525

